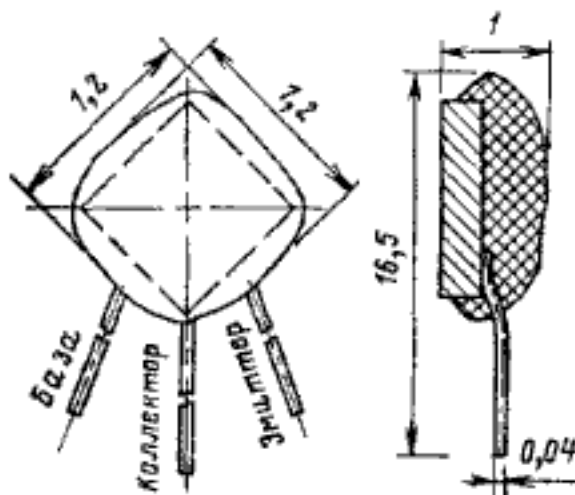


КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* маломощные универсальные.

Предназначены для использования в ключевых и линейных гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной герметичной аппаратуры.

Бескорпусные, без кристаллодержателя, с гибкими выводами, с защитным покрытием. Обозначение типа приводится на возвратной таре.

Масса транзистора не более 0,01 г.

Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала:

при $U_{ЭБ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА не менее:

КТ214А-1	20
КТ214Б-1	30–90
КТ214В-1	40–120
КТ214Г-1	40–120

при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 40$ мкА не менее:

КТ214Д-1	80
КТ214Е-1	40

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА КТ214Д-1, КТ214Е-1 не более	0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА КТ214Д-1, КТ214Е-1 не более	1,2 В
Напряжение насыщения эмиттер-коллектор при $I_B = 1$ мА, $I_3 = 0$ КТ214Д-1, КТ214Е-1	От 0,7 до 2,5 мВ
Входное сопротивление в режиме малого сигнала при $U_{ЭК} = 5$ В, $I_3 = 2$ мА, $f = 800$ Гц	От 1,2 до 10 кОм
типичное значение	2,5* кОм
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 500$ кГц	9,6–100 пФ
типичное значение	9,8* пФ
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 500$ кГц	9,5–50 пФ
типичное значение	12* пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм, $U_{КЭ} = 30$ В, $T = 358$ К не более	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

КТ214А-1, КТ214Б-1	80 В
КТ214В-1	60 В
КТ214Г-1	40 В
КТ214Д-1	30 В
КТ214Е-1	20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:

КТ214А-1	30 В
КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1	7 В
КТ214Е-1	20 В

Постоянный ток коллектора 50 мА

Импульсный ток коллектора при $\tau_{н} \leq 10$ мс, $Q \geq$
 ≥ 100 100 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

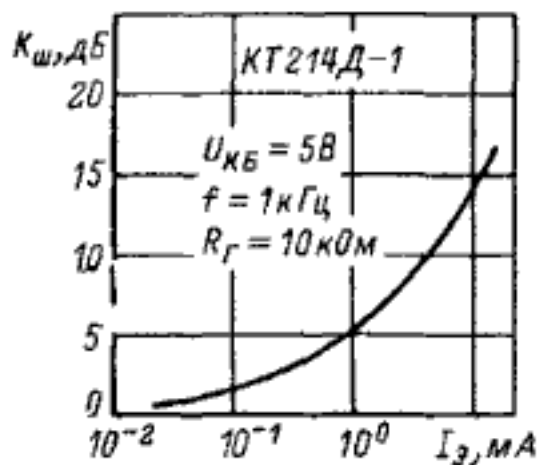
при $T = 298$ К	50 мВт
при $T = 358$ К	20 мВт

Температура перехода не более 398 К

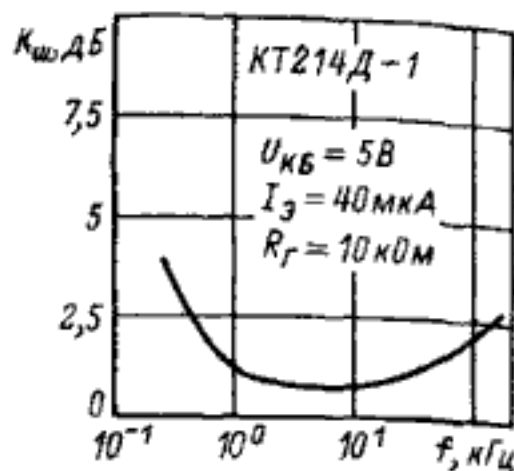
Тепловое сопротивление переход-кристалл 0,1 К/мВт

Температура окружающей среды От 233
до 358 К

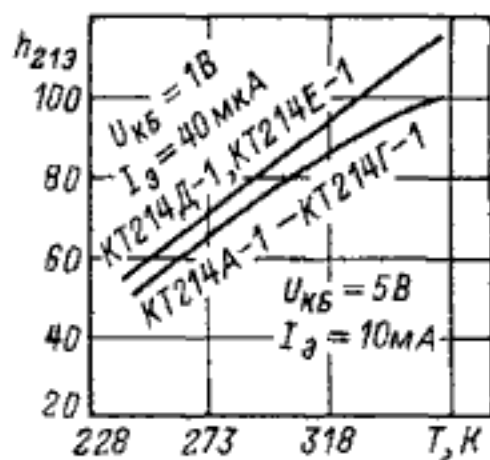
Примечание. Допустимая температура монтажа транзисторов в гибридные схемы не должна превышать 433 К в течение 30 с.



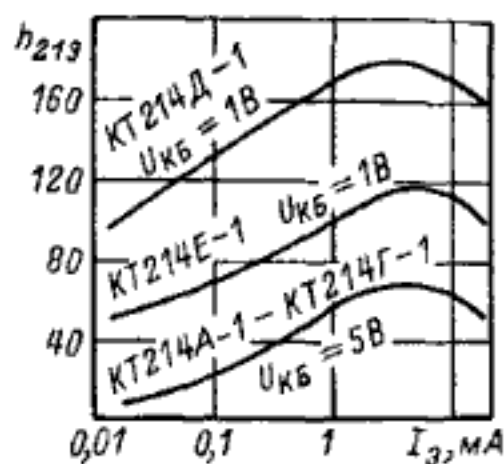
Зависимость коэффициента шума от тока эмиттера.



Зависимость коэффициента шума от частоты.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.